



НТЦ СИТ

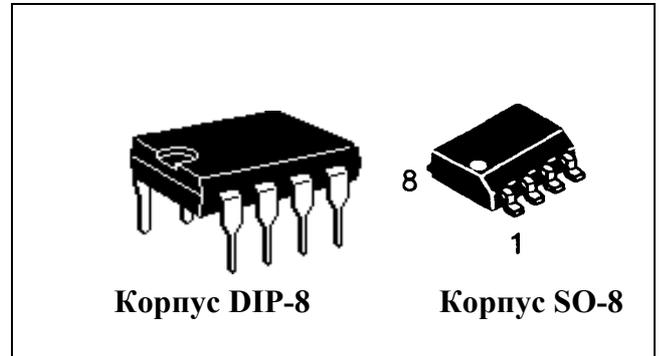
## СОГЛАСОВАННАЯ ПАРА ТРАНЗИСТОРОВ

### ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

КТ222АС – согласованная пара кремниевых NPN-типа проводимости транзисторных структур.

- Диэлектрическая изоляция
- Монолитная конструкция
- Близкое соответствие параметров от 10мкА до 1 мА – коэффициента усиления по постоянному току и напряжению база-эмиттер (100% тестирование)
- Превосходное тепловое соответствие
- Низкая взаимная емкость
- Поставка в кристаллах или в корпусе DIP-8

Применяется для гибридных сборок и схем дифференциальных усилителей.



Корпус DIP-8

Корпус SO-8

Аналог DI4044 (фирмы DIONICS Inc.)

Коллекторы транзисторов изолированы друг от друга, а также от нижней части кристалла. Посадка кристалла при сборке возможна на эвтектику или клей. Контактные площадки кристалла – алюминиевые.

### ОПИСАНИЕ ВЫВОДОВ

Назначение вывода	Обозначение	Номер вывода
Коллектор 1	C1	1
База 1	B1	2
Эмиттер 1	E1	3
Не используется	NC	4
Эмиттер 2	E2	5
База 2	B2	6
Коллектор 2	C2	7
Не используется	NC	8

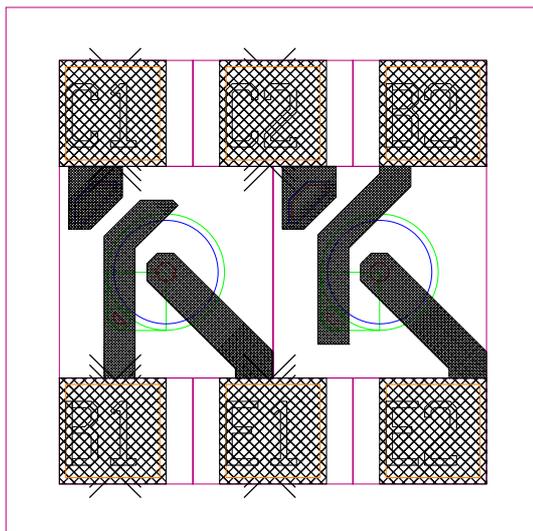
### ТОПОЛОГИЯ КРИСТАЛЛА

Размер кристалла – 0.5 мм x 0.5 мм

Размер контактных площадок – 100 x 100 мкм

Расстояние между контактными площадками – 40 мкм

Контактная площадка	C1	B1	E1	E2	B2	C2
X-координата (мкм)	61	61	200	339	339	200
Y-координата (мкм)	341	59	59	59	341	341
Вывод корпуса	1	2	3	5	6	7



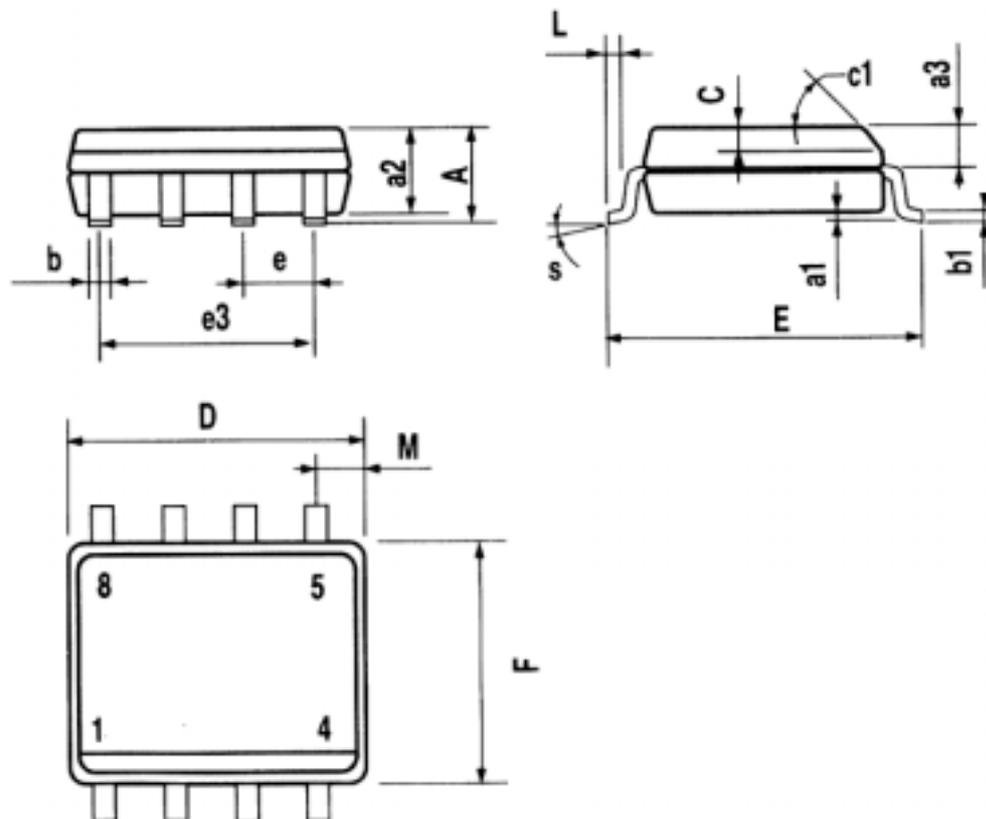
### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (Т = +25°C)

Основные электрические параметры при приемке и поставке должны соответ-

ствовать значениям, приведенным в таблице при температуре окружающей среды +25°C.

Наименование параметра	Буквен. обозн.	Норма не менее	Норма не более	Режим измерения	Един. изм.
1. Разность напряжений база-эмиттер	$(V_{BE1} - V_{BE2})$	-	3.0	$I_C = 10 \text{ мкА}; V_{CE} = 5 \text{ В}$	мВ
2. Отношение коэффициентов усиления	$h_{FE1} / h_{FE2}$	0.8	1.25	$I_C = 10 \text{ мкА}; V_{CE} = 5 \text{ В}$	-
3. Обратное напряжение коллектор-база	$V_{CBO}$	60	-	$I_C = 10 \text{ мкА}$	В
4. Обратное напряжение коллектор-база	$V_{CBO}$	60	-	$I_C = 10 \text{ мА}$	В
5. Обратное напряжение эмиттер-база	$V_{EBO}$	7	-	$I_E = 10 \text{ мкА}$	В
6. Обратный ток коллектор-базового перехода	$I_{CBO}$		1.0	$V_{CB} = 45 \text{ В}$	нА
7. Коэффициент усиления по постоянному току	$h_{FE}$	200	-	$I_C = 10 \text{ мкА}; V_{CE} = 5 \text{ В}$	-
8. Коэффициент усиления по постоянному току	$h_{FE}$	225	-	$I_C = 10 \text{ мА}; V_{CE} = 5 \text{ В}$	-
9. Межколлекторная емкость	$C_{CC}$	-	0.8	$V_{CC} = 5 \text{ В}$	пФ
10. Граничная частота	$f_T$	200	-	$I_C = 1 \text{ мА}; V_{CE} = 10 \text{ В}$	МГц

## ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ КОРПУСА SO-8



DIM	mm			inch		
	MIN.	TYP.	MAX.	MIN.	TYP.	MAX.
A			1.75			0.068
a1	0.1		0.25	0.003		0.009
a2			1.65			0.064
a3	0.65		0.85	0.025		0.033
b	0.35		0.48	0.013		0.018
b1	0.19		0.25	0.007		0.010
C	0.25		0.5	0.010		0.019
c1	45°(typ)					
D	4.8		5.0	0.188		0.196
E	5.8		6.2	0.228		0.244
e		1.27			0.050	
e3		3.81			0.150	
F	3.8		4.0	0.14		0.157
L	0.4		1.27	0.015		0.050
M			0.6			0.023
S	8°(max)					

## ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ КОРПУСА DIP-8

DIM	mm		
	MIN.	ТYP.	MAX.
A	3.25		3.45
a1	0.8		1.0
B	1.05		1.50
b	0.38		0.51
b1	0.2		0.3
D	9.6		10.0
E	7.95		9.75
e		2.5	
e3		7.5	
e4		7.62	
F	6.2		6.6
I	4.05		4.45
L	3.0		3.4

